ハイパスフィルタ・200–2300 MHz

阻止域減衰量 ≥40 dB (DC–130 MHz). 筐体寸法 10 ± 0.2 × 7.5 ± 0.2 × 4 ± 0.3 mm.

RF 特性

項目	値
通過帯域	200–2300 MHz
通過帯域内挿入損失 [1]	≤2 dB
阻止域減衰量 [2]	≥40 dB
VSWR [1]	≤1.8:1

[1] 200–2300 MHz
[2] DC–130 MHz

設計定格 設計値

項目	値
動作温度	−40...+70 °C
保存温度	−55...+85 °C
許容電力	1 W

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
1	213.35	100.47	-76.86	-76.86	2.44
22	1111.15	12536.23	-50.78	-50.78	2.04
44	759.68	347.2	-48.42	-48.42	1.62
65	268.02	203.51	-54.03	-54.03	-8.42
86	157.08	102.09	-56.28	-56.28	-12.41
108	67.41	47.73	-54.21	-54.21	-13.09
129	29.76	22.06	-48.2	-48.2	-17.5
151	9.52	6.92	-20.81	-20.81	5.88
172	1.41	1.11	-3.41	-3.41	13.75
193	1.22	1.16	-1.64	-1.64	6.85
215	1.13	1.12	-1.08	-1.08	4.28
236	1.23	1.23	-0.85	-0.85	3.1
257	1.25	1.25	-0.72	-0.72	2.39

代表実測応答

周波数 (MHz)	S11 VSWR	S22 VSWR	S12 損失（dB）	S12 抑圧（dB）	S12 遅延（ns）
279	1.24	1.22	-0.62	-0.62	2
300	1.2	1.18	-0.52	-0.52	1.74

機械仕様

項目	値
筐体寸法	10 ±0.2 × 7.5 ±0.2 × 4 ±0.3 mm
RF 端子	表面実装
品質グレード	産業用
パッケージRF端子の内縁間隔	8.8 mm
基板RFランドの内縁間隔	8.6 mm
対向するクリアランスの内縁間隔	7.2 mm
短辺方向のクリアランス開口幅	2.6 mm
パッケージRF端子幅	1.0 mm
基板RFランドの短辺方向幅	1.2 mm
パッケージRF端子の切り欠き径	Ø0.6 mm

実装とプリント基板レイアウト

底面視では、入出力を入れ替えられる2つのRF端子が対向する短辺の中央にあります。底面の斜線部はGNDです。基板中央寄りの各RFランドに50 Ω給電線を配線し、グラウンド銅箔との間隔を確保してください。フットプリントの周囲と下にグラウンドビアを設けてください。 推奨基板レイアウトには、誘電体厚0.254 mmのRO4350Bを使用します。 独立したキャビティへの実装を推奨します。十分な接地を確保するため、可能な限りパッケージの側面、上面および底面をアセンブリの金属筐体に密着させてください。接地が不十分だと阻止域の抑圧が低下します。220 °Cでのリフローはんだ付けに対応します。清掃時はフィルタを洗浄液に浸さず、表面のみを清掃してください。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。